

D45XT160**1600V 45A****特長**

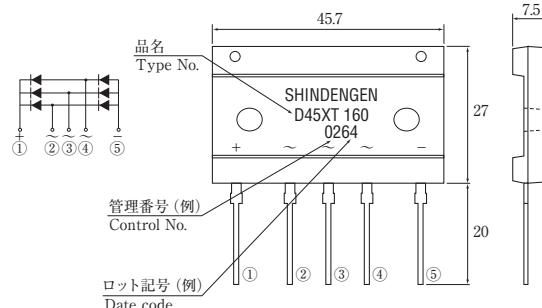
- 3相ブリッジ
- 薄型 SIP パッケージ
- UL E142422
- 高放熱伝導性

Feature

- 3 Phase-Bridge
- Thin-SIP
- UL E142422
- High Thermal Radiation

■外観図 OUTLINE

Package : TSB-5PIN

Unit : mm
Weight : 22g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

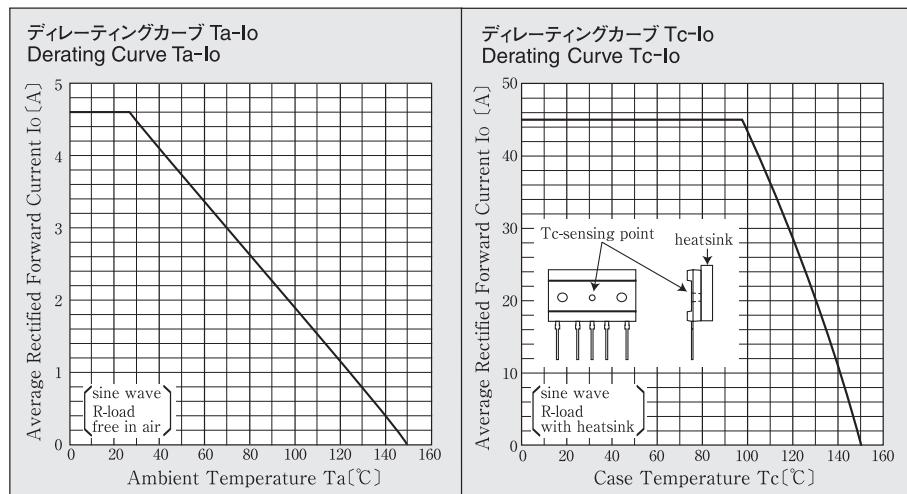
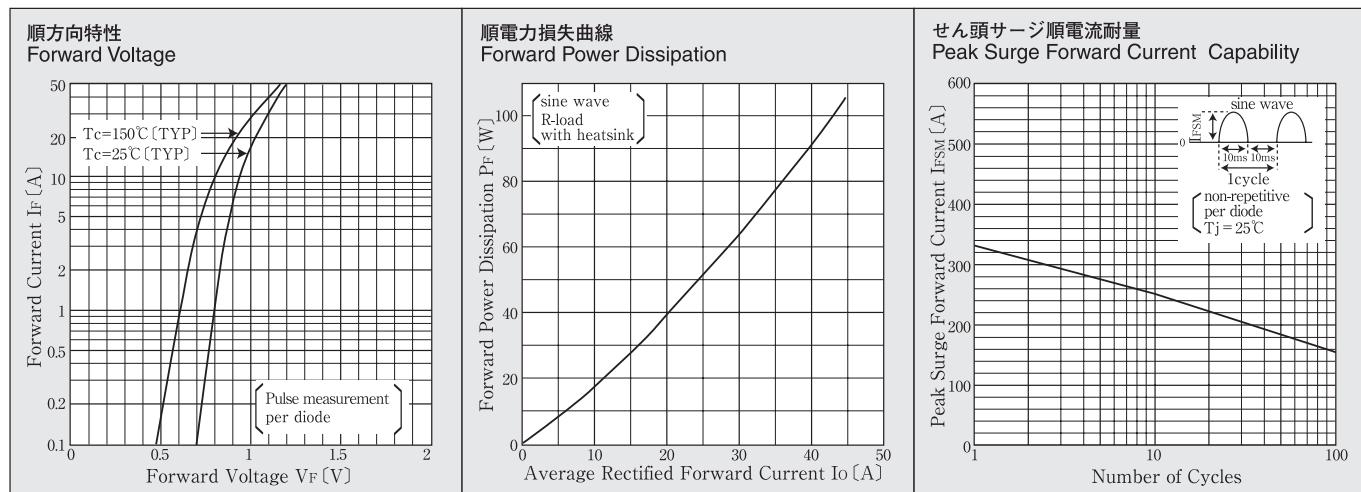
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は Tc=25°C / unless otherwise specified)**

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 品名 Type No. | D45XT160 | 単位 Unit |
|--|------------------|--|--|-------------|------------------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | | -40~150 | °C |
| 接合部温度 Operation Junction Temperature | T _j | | | 150 | °C |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | V _{RM} | | | 1600 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | I _O | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load | フィン付き With heatsink T _c =97°C フィンなし Without heatsink T _a =26°C | 45.0 4.6 | A |
| せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current | I _{FSM} | 50Hz 正弦波 50Hz sine wave 60Hz 正弦波 60Hz sine wave | 非繰り返し1サイクルせん頭値, 1素子当たりの規格値, T _j =25°C Non-repetitive 1cycle peak value, Per diode T _j =25°C | 330 360 | A |
| 電流二乗時間積 Current Squared Time | I ² t | 1ms ≤ t < 10ms, | 1素子当たりの規格値 per diode | 544.5 | A ² s |
| 絶縁耐圧 Dielectric Strength | V _{dis} | 一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 モールド部上面(端子と平行面)は除く Terminals to case, AC 1 minute. Except top (opposite side of the terminal side) of the mold case. | | 2.5 | kV |
| 締め付けトルク Mounting Torque | T _{OR} | (推奨値: 1.2 N·m) (Recommended torque : 1.2 N·m) | | 1.5 | N·m |

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は Tc=25°C / unless otherwise specified)

| | | | | |
|------------------------|-----------------|--|----------|------|
| 順電圧 Forward Voltage | V _F | I _F =15A, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode | MAX 1.05 | V |
| 逆電流 Reverse Current | I _R | V _R =1600V, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode | MAX 100 | μA |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ _{jc} | 接合部・ケース間 Junction to case | MAX 0.5 | °C/W |
| | θ _{ja} | 接合部・周囲間 Junction to ambient | MAX 16 | |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.